Mikroelektronika BMEVIEEAB01 2023/24 I. félév Szóbeli vizsgarész

Elméleti feladatok tételsora

- 1. A **mikroelektronika fejlődési trendjei**, More-than-Moore integráció, modern áramköri tokozások, SoC/SiP/SoP 3D integráció.
- 2. A **PN átmenet** működése, felépítése (kiürített tér, sávábra, nyitó/záró irányú működés, másodlagos jelenségek, ...).
- 3. **Integrált áramköri bipoláris tranzisztor** működése, felépítése (homogén/inhomogén bázis, FB és FE működés, ...).
- 4. Integrált áramköri JFET tranzisztor működése, felépítése.
- 5. Integrált áramköri, <u>kiürítéses</u>, n csatornás fém-oxid-félvezető térvezérlésű tranzisztor (MOS-FET) működése, felépítése.
- 6. Integrált áramköri, <u>növekményes</u>, n csatornás fém-oxid-félvezető térvezérlésű tranzisztor (MOS-FET) működése, felépítése.
- 7. MOS kapacitás struktúra és a MOS eszközök működése közben fellépő felületi jelenségei.
- 8. **Korszerű CCD** és **CMOS képérzékelő szenzorok** működése, felépítése, fejlődése.
- 9. Integrált áramköri, növekményes, n csatornás **MOS-FET tranzisztor küszöbfeszültség függése**, korlátozó tényezők.
- 10. Modern CMOS technológián, **CMOS** áramköri kapcsolástechnikával megvalósított áramkörök fogyasztás-összetevői.
- 11. Modern, alacsony tápfeszültségű CMOS technológián megvalósított **komplex logikai** áramkörök kapcsolástechnikai módszerei.